

## 第六届全国半导体物理学术会议简讯

第六届全国半导体物理学术会议已于 1987 年 12 月 24—28 日在广州举行。来自全国 68 个单位的代表 320 人参加了会议，还有 24 人列席了会议。大会由谢希德教授致开幕词。黄昆教授在大会上作了题为“超晶格与量子阱的若干问题”的学术报告。会议安排了六个分会场进行学术报告共 298 篇。其中涉及表面与界面原子结构、电子态及物性研究的 40 篇；低维电子系统与超晶格的 46 篇；体电子结构及光学性质的 30 篇；材料物理的 38 篇；器件物理的 30 篇；其它方面的 12 篇。此外，还采纳了 133 篇工作报告摘要收入会议文摘汇编中。

从会议的学术交流情况看到，第五届会议以来的两年中，国内在低维电子系统及超晶格和量子阱方面的研究工作很活跃。在基础理论、超晶格量子阱材料制备、物性研究、以及有关器件的物理基础研究等方面的研究报告的篇数，由上届会议的很小一个数目激增至 65 篇。由于这一领域的十分吸引人的广阔前景，可以预期今后会有更多的研究力量投入这方面的工作。黄昆教授在大会上所作的学术报告将起着指引作用。

在表面和界面研究方面，除了表面原子结构、表面界面电子态的基础研究外，还有较多的工作属于硅金属化合物与硅界面的形成和物性、异质半导体之间的界面、金属与半导体的接触、甚至绝缘体铁电体与半导体接触等有着强烈应用背景的研究工作。

关于体电子结构、电子输运过程及光学过程等方面的研究报告篇数虽较少，但在硅化物、III-V 族、II-VI 族的二元三元化合物方面的论文物理内容较深入，水平较高。

在杂质和缺陷能级研究方面，对硅、III-V 族和 II-VI 族化合物半导体中的一些重要杂质缺陷进行了较深入的实验和理论研究。某些杂质缺陷的局域振动模研究也受到了重视。

非晶半导体方面对一些可能有重要应用的课题所开展的研究工作十分活跃。研究报告的篇数比上届增加近一倍。所使用的研究手段和研究问题的深入程度都有了显著的提高。

材料物理和器件物理所开展的应用基础研究工作，多是围绕着超大规模集成电路或超快速器件及各种功能器件进行的。这些都是为发展我国的半导体工业或者为消化引进的有关技术所不可缺少的。

总之，从这次会议可以看到，半导体物理学界都正在为我国科学技术的进步努力地工作着，并取得了很多重要的成果，必将会对我国生产力的提高起重要的促进作用。本届会议上还安排了各个领域共 35 个专题报告，同时还进行了青年研究生优秀论文的遴选。

经过酝酿讨论，会议认为向《国际纯粹与应用物理协会半导体专业委员会》申请由我国北京主办 1992 年第 21 届国际半导体物理会议是适宜的。并建议这一会议的两个国际卫星会议分别在上海和厦门举行。会议还讨论决定第七届全国半导体物理学术会议将于 1989 年在上海举行，由复旦大学和中国科学院上海技术物理研究所联合举办。第八届会议将于 1991 年在北京举行。  
（徐 耕）

### News in Brief—Sixth National Conference on Physics of Semiconductors

Guangzhou, Guangdong, Dec. 24—28, 1987